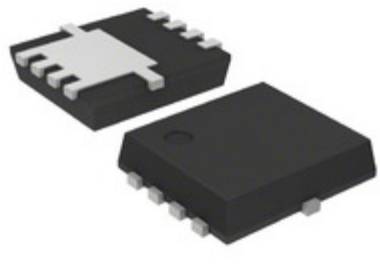









	<h2 style="color: red;">TPN4R712MD,L1Q</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPN4R712MD,L1Q
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 36A 8TSON ADV
Datenblätter:	 TPN4R712MD,L1Q.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TPN4R712MD,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 36A 8TSON ADV
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVI
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 18A, 4.5V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4300pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)

TPN4R712MD,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN4R712MD,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN4R712MD,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPN4R712MD,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPN4R712MD TOSHIBA TPN4R712MD TOSHIBA</p>	 <p>TPN4R203NC,L1Q(M TOSHIBA TPN4R203NC,L1Q(M TOSHIBA</p>	 <p>TPN4R303NL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 63A 8TSON</p>	 <p>TPN4R303NL TOSHIBA TPN4R303NL TOSHIBA</p>
 <p>TPN4R806PL TOSHIBA TPN4R806PL TOSHIBA</p>	 <p>TPN4R203NC,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 23A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN6R003NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 27A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN6R003NL TOSHIBA TPN6R003NL TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPN4R712MD,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPN4R712MD,L1Q Datenblatt	TPN4R712MD,L1Q-Datenblätter	TPN4R712MD,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPN4R712MD,L1Q
TPN4R712MD,L1Q Electronic	TPN4R712MD,L1Q-Komponenten	TPN4R712MD,L1Q-Verteiler	TPN4R712MD,L1Q-Bild	TPN4R712MD,L1Q-Teil
TPN4R712MD,L1Q Preis	TPN4R712MD,L1Q Hersteller	TPN4R712MD,L1Q Bild	TPN4R712MD,L1Q Aktie	TPN4R712MD,L1Q Inventar
TPN4R712MD,L1Q Neu	TPN4R712MD,L1Q Original	TPN4R712MD,L1Q garantiert	TPN4R712MD,L1Q RFQ	TPN4R712MD,L1Q Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited